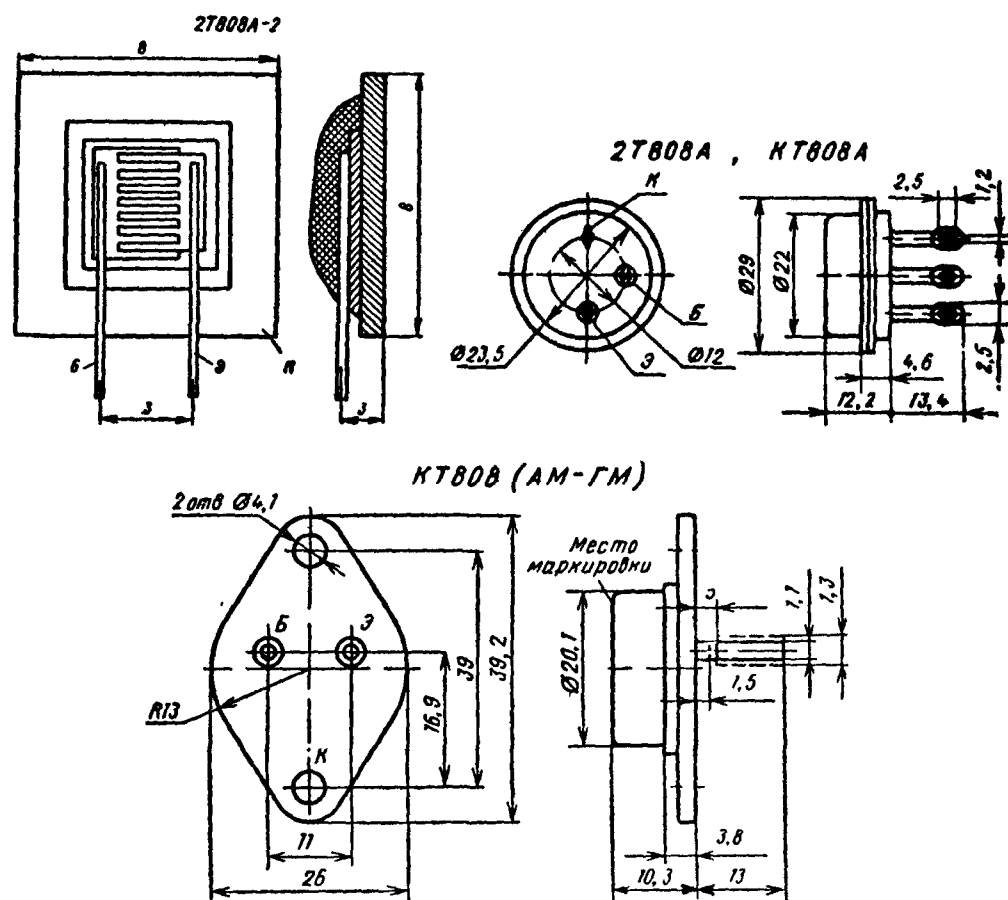


2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808 (АМ, БМ, ВМ, ГМ)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры $p-n-p$ переключающего типа. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ — КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при $U_{кэ}=3$ В,
 $I_k=6$ А:

$T=+25^\circ\text{C}$	10...15*...50
$T=+125^\circ\text{C}$ 2Т808А и $T=+100^\circ\text{C}$ КТ808А	10...20*...150
$T=-60^\circ\text{C}$	6...10*...50

КТ808АМ—КТ808ГМ при $U_{кэ}=3$ В, $I_k=2$ А

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ}=10$ В, $I_b=0,5$ А, $f=3,5$ МГц, не менее

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер КТ808АМ—КТ808ГМ при $I_k=6$ А, $I_b=0,6$ А, не более

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k=6$ А, $I_b=0,6$ А

Время рассасывания при $U_{кэ}=15$ В, $I_k=6$ А, не более

Обратный ток коллектор — эмиттер при $R_{сэ}=10$ Ом, не более:

$T=+25$ и -60°C и $U_{кэ}=200$ В 2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ}=120$ В КТ808А	3 мА
---	------

$T=+125^\circ\text{C}$, $U_{кэ}=160$ В 2Т808А, 2Т808А-2	20 мА
$T=+100^\circ\text{C}$, $U_{кэ}=120$ В КТ808А	50 мА

Обратный ток коллектора КТ808АМ—КТ808ГМ при $U_{кэ}=U_{кэ, макс}$, $T=+25^\circ\text{C}$, не более

Обратный ток эмиттера при $U_{бэ}=4$ В, не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{кэ}=10$ В, $f=1$ МГц, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер¹ при $R_{сэ}=10$ Ом, $T_n \leq 100^\circ\text{C}$:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	120 В
КТ808АМ	130 В
КТ808БМ	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер¹ при $U_{бэ}=2$ В или $R_{сэ}=10$ Ом, $t_u \leq 500$ мкс, $t_p \geq 30$ мкс, $Q \geq 7$, $T_n \leq +100^\circ\text{C}$

Постоянное напряжение эмиттер — база:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	4 В
КТ808АМ—КТ808ГМ	5 В

Постоянный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_n = -60...+50^\circ\text{C}$:

с теплоотводом:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	50 Вт
КТ808АМ—КТ808ГМ	60 Вт

без теплоотвода 2Т808А, КТ808А

	5 Вт
--	------

Тепловое сопротивление переход — корпус

	2°С/Вт
--	--------

Температура $p-n$ перехода

	+150°С
--	--------

Температура окружающей среды:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808АМ—КТ808ГМ	-60°С... $T_n=+125^\circ\text{C}$
КТ808А	-60°С... $T_n=+100^\circ\text{C}$

¹ При $T_n = +100...+150^\circ\text{C}$ постоянное и импульсное напряжения коллектор — эмиттер снижаются линейно на 10% на каждые 10°С. Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_{\text{н}} + R_{T(n-\pi)}(P_k + P_b).$$

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А-2 не более +250°С, 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ не более +275°С в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А-2 составляет 300 В.